

中微半导体（深圳）股份有限公司

关于自愿披露公司发布新产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 近日，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导”、“公司”）即将推出首款非易失性存储器芯片，该产品为 4M bit 容量的低功耗 SPI NOR Flash，存储阵列共 2048 个可编程页，每页容量为 256 字节，单次可编程写入数据量最高可达 256 字节，支持多种擦除模式，具有低成本、低功耗、SPI 高速读写、掉电不丢失特点，适配小存储需求场景。
- 本次新产品的发布，是公司实施“MCU+”战略的最新成果，填补了公司在 Flash 领域的产品空白，标志着公司正式向 Flash 领域迈出实质性一步，体现了公司技术创新能力和产品开发能力的拓展，进一步丰富了公司产品矩阵和产品形态，拓宽了公司产品应用场景和使用范围，将有助于巩固和提升公司综合竞争力，对公司未来发展将产生积极的影响。
- 本次发布的新产品未来要实现大规模销售，存在市场推广与客户开拓不及预期的风险；NOR Flash 市场规模相对较小且竞争日趋激烈，公司作为新进入者，可能出现亏损性推广影响公司整体盈利能力的风险；巨大的研发投入，可能影响传统产品的更新迭代速度，从而出现拖累传统领域优势产品竞争力的风险；存储产品系列化进展、结果和市场不确定性风险；产品周期性引起公司营收周期性波动的风险。

一、新产品基本情况

公司首款非易失性存储芯片，产品型号为 CMS25Q40A，容量为 4M bit 的 SPI NOR Flash 芯片，存储阵列划分为 2048 个可编程页，每页容量为 256 字节。单次编程操作最多可写入 256 字节数据。支持多种擦除方式，包括 4 页一组的 1KB 扇区擦除、16 页一组的 4KB 扇区擦除、128 页一组的 32KB 块擦除、256 页一组的 64KB 块擦除，以及整片擦除。具有低成本、低功耗、SPI 高速读写、掉电不丢失等特点，适配小存储需求场景，包括嵌入式 MCU 程序存储、小型智能硬件配置存储、低功耗 IoT 终端存储以及外设/模块配套存储等场景。具体性能参数如下：

1. 采用单电源供电，电压范围为 1.65V 至 3.6V。
2. 全系列产品均采用小型封装，节省空间。
3. 支持标准串行外设接口（SPI），同时兼容高性能的双路/四路输出模式以及双路/四路输入输出（I/O）SPI 模式。
4. 支持最高 120MHz 的 SPI 时钟频率。
5. 芯片配备保持引脚、写保护引脚，并支持可编程写保护功能，可灵活控制存储阵列的顶部、底部或互补区域的写保护状态。
6. 支持标准 SPI 及高性能双路/四路 I/O/SPI 接口，兼具灵活的擦写方式与可靠的保护机制。
7. 安全特性：配备 $4 \times 256 = 1024$ 字节安全存储器、支持一次性可编程锁定，内置 64 位唯一序列号。

产品型号	产品性能指标
CMS25Q40A	<p>容量大小：4Mb 串行 Flash</p> <p>等效字节容量：512K 字节</p> <p>单页容量：256 字节</p> <p>高速时钟频率：120MHz 时钟频率</p> <p>XIP 操作：支持 8/16/32/64 字节长度的循环连续读取</p> <p>存储寿命：50 年</p> <p>擦写寿命：最小编程/擦除循环次数为 200,000 次</p> <p>待机功耗：7uA</p> <p>封装：8-pin SOP/150 mil 和 8-pad USON8 2X3 mm</p>

	Page 编程时间： 1.25ms Sector /Block/chip 擦除时间： 2.5ms/2.5ms/5ms
--	---

二、新产品对公司的影响

本次发布的 CMS25Q40A 产品，是公司首款 Flash 产品，填补了公司在 Flash 领域的产品空白，是公司有效推行“MCU+”战略的最新成果，标志着公司正式向存储领域迈出实质性一步，彰显了公司核心技术创新与产品开发能力的拓展，为后续拓展 Flash 产品容量谱系、Flash 产品系列化奠定了坚实基础，同时丰富了产品矩阵与形态、拓宽了应用场景，增强了公司在智能控制解决方案上一站式整体解决能力。

这款新品成功推出有效巩固并提升了综合竞争力，为开拓存储新市场、挖掘业务增长极提供有力支撑，对公司长远发展具有重要意义，对公司未来市场拓展和业绩成长性预计将产生积极的影响。

三、相关风险提示

1、公司本次发布的非易失性存储芯片，但尚未进行市场推广，未来要实现大规模销售，尚需通过更多客户对该产品进行试用和评估，存在市场推广与客户开拓不及预期的风险。

2、存储芯片市场由 DRAM、NAND Flash 和 NOR Flash、EEPROM 等细分市场组成，其中 DRAM 和 NAND Flash 占据了存储芯片市场的主要份额，NOR Flash 市场规模相对较小且竞争日趋激烈。国内主要参与者包括兆易创新和普冉股份等上市公司，它们已经在存储芯片领域深耕多年，具有技术积累深厚、产品系列化

完善、市场品牌度高和客户认可的优势，公司作为存储芯片市场新进入者，如果公司不能及时完善产品系列化或未能较好地应对外部竞争压力，可能面临亏损性推广而存在影响公司整体盈利能力的风险。

3、公司存储芯片还需要解决产品系列化问题，后续系列化研发必将占据公司大量研发资源，可能挤占公司传统 MCU 产品研发投入，影响传统产品的更新迭代速度，削弱传统领域优势产品竞争力的风险。

4、存储产品系列化能否如期完成、性能指标是否达标、是否具有竞争力、产能能否满足、市场因素等尚不确定性的风险。

5、存储类产品季节性、周期性波动明显，即使公司该类产品得到大量推广，可能存在公司营收周期性波动的风险。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日